









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD80R4K5P7ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD80R4K5P7ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 1.5A DPAK
Datenblätter:	 IPD80R4K5P7ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R4K5P7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	13W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	80pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)

IPD80R4K5P7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R4K5P7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R4K5P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R4K5P7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD80R4K5P7 INFINEON IPD80R4K5P7 INFINEON	 IPD85P04P4L-06 INFINEON IPD85P04P4L-06 INFINEON	 IPD80R2K8CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3	 IPD80R750P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 7A TO252-3
 IPD80R360P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 13A TO252-3	 IPD85P04P407ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3	 IPD80R3K3P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3	 IPD80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R4K5P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R4K5P7ATMA1 Datenblatt	IPD80R4K5P7ATMA1-Datenblätter	IPD80R4K5P7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R4K5P7ATMA1
IPD80R4K5P7ATMA1 Electronic	IPD80R4K5P7ATMA1-Komponenten	IPD80R4K5P7ATMA1-Verteiler	IPD80R4K5P7ATMA1-Bild	IPD80R4K5P7ATMA1-Teil
IPD80R4K5P7ATMA1 Preis	IPD80R4K5P7ATMA1 Hersteller	IPD80R4K5P7ATMA1 Bild	IPD80R4K5P7ATMA1 Aktie	IPD80R4K5P7ATMA1 Inventar
IPD80R4K5P7ATMA1 Neu	IPD80R4K5P7ATMA1 Original	IPD80R4K5P7ATMA1 garantiert	IPD80R4K5P7ATMA1 RFQ	IPD80R4K5P7ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited